# 直交変調型 EPWM 送信機アップコンバージョン回路の InGaAs 系 HEMT を用いた設計 7310117 野田 昂志

# 1. はじめに

現在,移動体通信システムにおける消費電力の半分以上 が電力増幅器によって消費されている.そこで電力効率を 上げるための方式として直交変調型 EPWM 送信機[1][2]が 提案されている.また,近年通信の高速化や周波数資源の 枯渇などにより,ミリ波帯を用いた高速無線通信の実現が 望まれている.そこで,注目されている高速デバイスが高 電子移動度トランジスタ(HEMT: High Electron Mobility Transistor)である.現在直交変調型 EPWM 送信機 RF 回路の 一部であるアップコンバージョン(U/C)部は IC 化設計に向 けて,回路設計用ソフト上でシミュレーションが行われて いる[3].しかし,MOSFET を用いた設計ではミリ波帯にお いて利得が十分でなく高速動作が困難となる.

従って、本研究では InGaAs 系 HEMT を用いて設計する直 交変調型 EPWM 送信機 U/C 回路を提案し 1GHz で動作確認を すると共に EVM(Error Vector Magnitude)評価を行う.

# 2. 直交変調型 EPWM 送信機

本研究で用いる直交変調型 EPWM 送信機を図 1 に示す.直 交変調型 EPWM 送信機ではベースバンド信号の I-ch, Q-ch は別々に 3 値 $\Delta \Sigma$ 変調器によりパルス密度変調される. 3 値 $\Delta \Sigma$ 変調器は NULL 状態を表現でき, I-ch と Q-ch の信号 は正("1","0"), 負("-1","0")として出力される. その後, I-ch, Q-ch 信号は搬送波周波数 f<sub>c</sub> に変調され交互出力され ることで I-ch, Q-ch 信号の重なりを防ぎ,量子化雑音が低 減される. 電力増幅器により増幅された信号は,必要な帯 域のみが送信される.

図2に示す交互出力はI-chとQ-chの信号を合成する前 にあらかじめ半周期ずれたfc/2のSINCLKを論理的に掛け 合わせることで合成した際にアナログ的な波形歪みやオー バーラップが生じず,雑音を低減させることができる.



### 3. アップコンバージョン回路

図3にInGaAs系HEMTを用いて設計したU/C回路を示す. 搬送波変調部及び交互出力部(図3(a))はマルチプレクサ (MUX)[4]で設計する.MUXは入力バッファ、セレクトコア によって構成する.入力バッファは5段の差動アンプによ って構成し、セレクトコアは.2段の差動回路により構成 する.MUXにおいて、電源電圧をV<sub>DD</sub>,V<sub>CS</sub>,V<sub>SS</sub>,R<sub>C</sub>を抵抗, C<sub>1</sub>を容量とする.正負合成部は図3(b)のようなプッシュプ ル回路を用いる.また、構成したU/C回路の論理動作波形 を図4に示す.







# 4. 評価方法

#### 4.1 シミュレーション方法

シミュレーションの構成を図5に示す. Math Works 社 の数値解析ソフト MATLAB/Simulink を用いて I-ch, Q-ch の信号を3値⊿∑変調器で量子化する. その信号を Agilent 社の回路設計用ソフト Advanced Design System(ADS)上 で設計した回路に入力し変調及び交互出力を行い、合成す る. その後,再び信号を MATLAB/Simulink 上に戻し,直 交検波し EVM 評価を行う.



MATLAB/Simulink ADS MATLAB/Simulink (Advanced Design System) 復調 図 5. シミュレーション構成図

4.2. シミュレーション諸元

シミュレーション諸元を表 1~3 に示す.

	16  QAM	
シン	10 [Msymbol/s]	
搬送波周波数(fa)		1 [GHz]
ロールオフ	ロールオフファクタ	0.7
フィルタ	サンプリング周波数(fc)	500 [MHz]
(ルート	打ち切りサンプル数	16
コサイン	アップサンプリング	50
フィルタ)	ファクター	
$\bigtriangleup \Sigma$	次数	2
変調器	オーバーサンプリング	50
	レート	
BPF	次数	4
(バタワース)	中心周波数	fc
	帯域幅	$0.5  [\mathrm{GHz}]$

表 1. MATLAB の諸元

表2. 設計回路の諸元

$V_{DD}$	3.5 [V]	$V_{DD2}$	1 [V]
$V_{CS}$	-1.6 [V]	$R_L$	$50 [\Omega]$
$V_{SS}$	-1.1 [V]	$C_2$	0.318 [nF]
$R_C$	$75[\Omega]$	п	1
$C_1$	$10 [\mathrm{pF}]$		

表 3. トランジスタの諸元			
種類	InGaAs 系 HEMT		
ゲート長	80 [nm]		
ゲート幅	25 [um] (フィンガー数:1)		

#### 5. 結果

MATLAB/Simulink 上で生成した信号を ADS 上で設計 した回路に通し、復調した際のコンスタレーション及び EVM を図6に示す. コンスタレーションより1GHzにお いて ADS 上で設計した回路が正しく動作し、I-ch, Q-ch 信号が搬送波に変調され、交互出力されていることが読み 取れる. また, EVM は 27.3[dB]を示し 27[dB]を超える良 好な結果が得られた. この値は, IEEE 802.11ac の基準に おいて 64QAM 変調方式で十分に識別出来ることを示す. 今後は、更なる EVM の改善及びミリ波帯において動作の 検証を行うことを課題とする.



図 6. コンスタレーション及び EVM

## 6.まとめ

本研究では、ミリ波帯で動作する直交変調型 EPWM 送信 機の U/C 回路を構成するために,InGaAs 系 HEMT を用 い回路の設計を行い 1GHz にて動作確認を行った.結果, I-ch 及び Q-ch の入力信号が正常に搬送波変調, 交互出力 され,合成された波形として出力されることが確認できた. また,設計した回路を通して復調した結果, EVM:27.3[dB] という良好な結果が得られた. 今後は、ミリ波帯での動作 の検証を行うと共に EVM の改善を課題とする.

#### 診考文献

Y. Wang, "A class-s RF amplifier architecture with envelope deltasigma modulation," IEEE Radio & Wireless Conference, RAWCON2002, pp. 177-179, 2002.
H. Izumi, M. Kojima, Y. Umeda, O. Takyu, "Comparison between Quadrature- and Polar-modulation Switching -mode Transmitter with Pulse-density Modulation", ICACT, pp. 1140 - 1145 Jun 2013

multiplexer IC using InAlAs/InGaAs/InP HEMTs ", IEEE J. SSCS, pp. 183-186, Oct. 1997.